



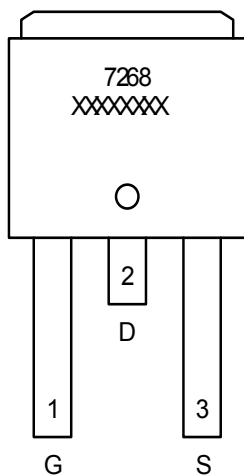
7268 (文件编号: S&CIC1228)

N 沟道场效应功率管

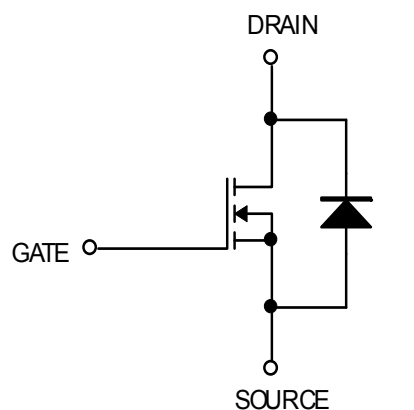
$V_{DS} = 30V$

$R_{DS(ON)}, V_{GS}@4.5V, I_{DS}@20A = 7.5m\Omega@TYP$

$R_{DS(ON)}, V_{GS}@10V, I_{DS}@20A = 4.5m\Omega@TYP$



TO-252



N-Channel MOSFET

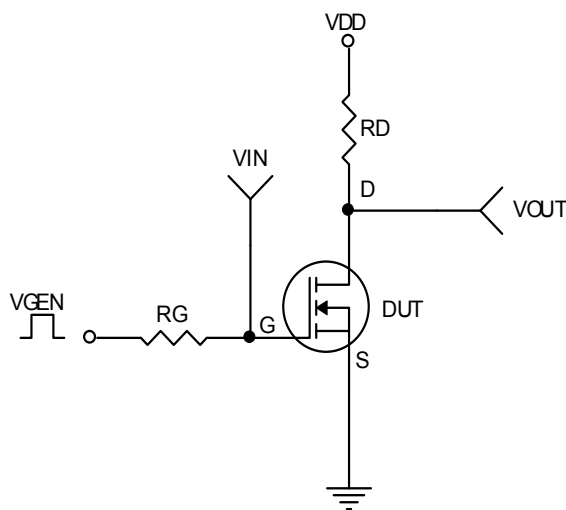
产品应用

- 用于航模螺旋桨驱动
- 其它需大电流驱动的产品

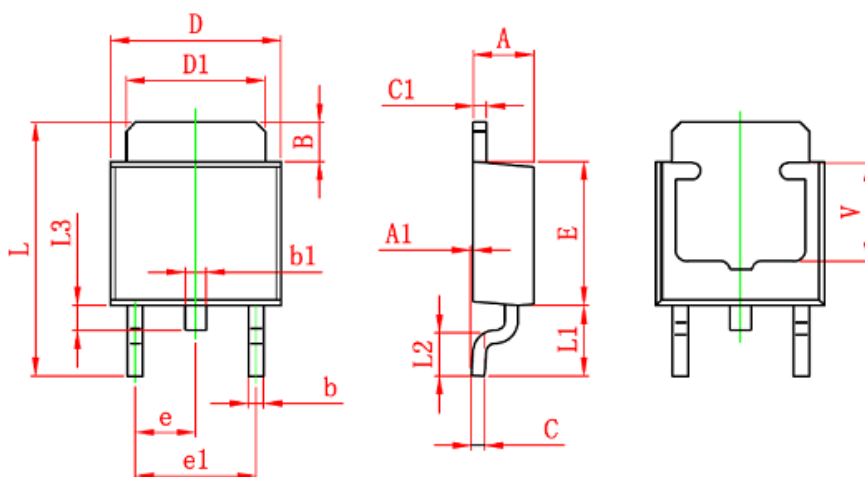
电特性 ($T_A=25^\circ C$, 除非另有说明。)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
漏源击穿电压	$V_{(BR)DSS}$	$V_{GS}=0V, I_{DS}=250\mu A$	30	33.5	--	V
漏极持续电流	$I_{D(Device Ref.)}$	$T_J=25^\circ C$	--	--	80	A
栅源短路时漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS}=30V, V_{GS}=0V, T_J=25^\circ C$	--	--	1	μA
漏极短路时截止栅电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20V$	--	--	± 100	nA
栅极阈值电压	$V_{GS(TH)}$	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu A$	1	1.5	2.5	V
漏源内阻	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=10V, I_D=20A$	--	4.5	6.5	m Ω
		$V_{GS}=2.5V, I_D=0.5A$	--	7.5	10.5	

开关测试电路



封装信息 (TO-252)



符号	单位: 毫米		单位: 英寸		符号	单位: 毫米		单位: 英寸	
	最小	最大	最小	最大		最小	最大	最小	最大
A	2.200	2.400	0.087	0.094	E	5.400	5.700	0.213	0.224
A1	0.000	0.127	0.000	0.005	e	2.300 TYP.		0.091 TYP.	
B	1.350	1.650	0.053	0.065	e1	4.500	4.700	0.177	0.185
b	0.500	0.700	0.020	0.028	L	9.500	9.900	0.374	0.390
b1	0.700	0.900	0.028	0.035	L1	2.550	2.900	0.100	0.114
c	0.430	0.580	0.017	0.023	L2	1.400	1.780	0.055	0.070
c1	0.430	0.580	0.017	0.023	L3	0.600	0.900	0.024	0.035
D	6.350	6.650	0.250	0.262	V	3.800 REF.		0.150 REF.	
D1	5.200	5.400	0.205	0.213					